

**关键指标**

频率：6~18GHz  
增益：14.5dB  
1dB 压缩点输出功率：21dBm  
饱和输出功率：22dBm  
电压/静态电流：+7V/120mA  
外形尺寸：3mm×1.25 mm

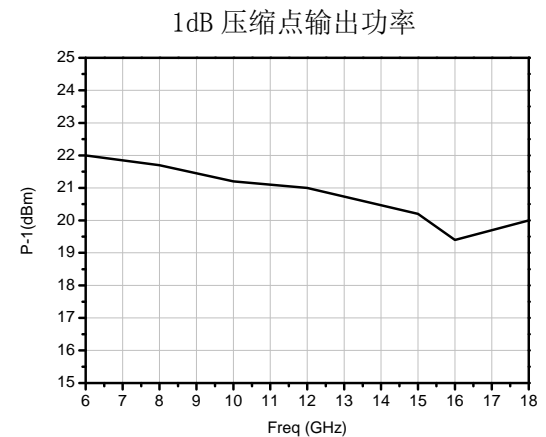
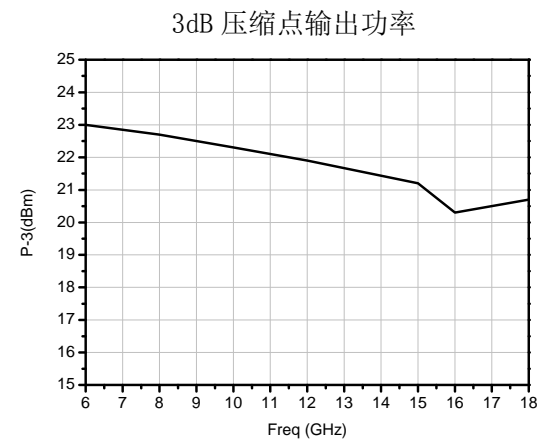
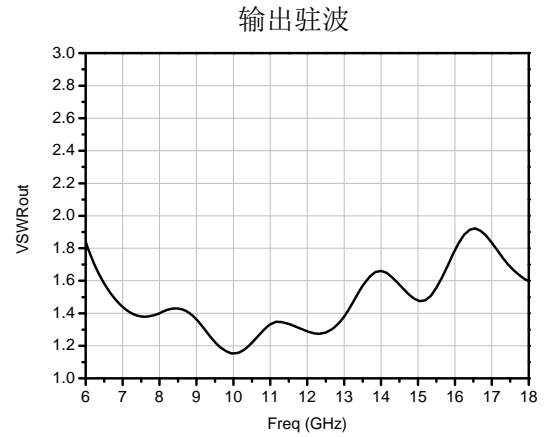
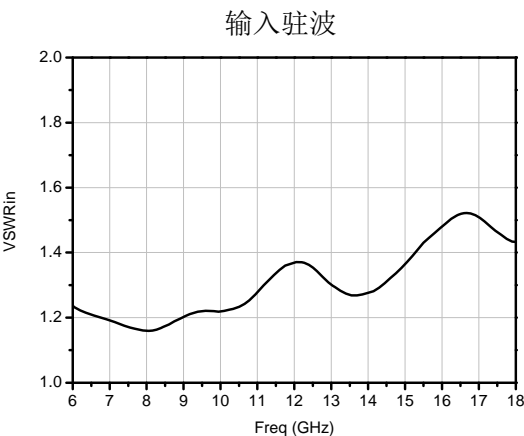
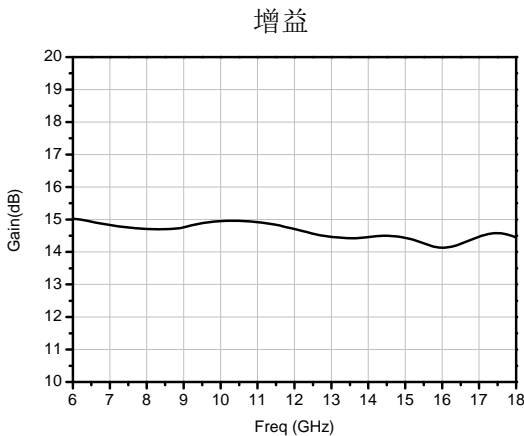
**产品简介**

HG126F6 型芯片是一款宽带中功率放大器芯片，采用 GaAs pHEMT 工艺制作，采用单电源+7V 供电，静态电流为 120mA，电源端需要加滤波电容，射频输入输出端均已集成隔直电容。

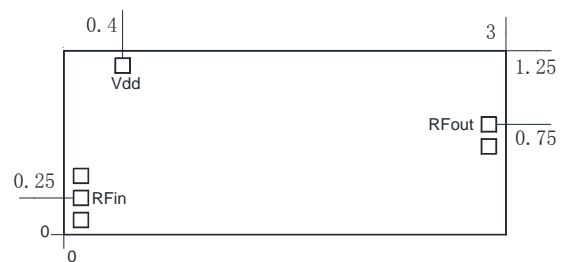
**电性能 (T<sub>a</sub>=25°C, V<sub>dd</sub>=+7V)**

指标	最小值	典型值	最大值
频率 (GHz)	6~18		
增益 (dB)	-	13	-
增益平坦度 (dB)	-	±0.5	-
输入驻波	-	1.4	-
输出驻波	-	1.6	-
1dB 压缩点输出功率 (dBm)	-	21	-
饱和输出功率 (dBm)	-	22	-
静态电流 (mA)	-	120	-

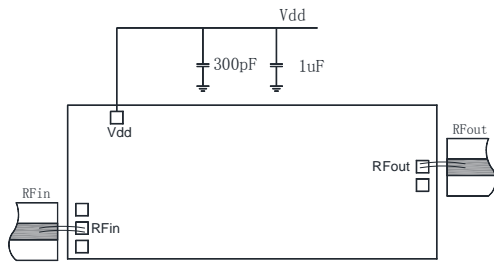
**典型测试曲线**



**外形和端口尺寸 (mm)**



推荐装配图



绝对额定最大值

工作电压	+9V
最大输入功率	+15dBm
工作温度	-55℃~125℃
存储温度	-65℃~150℃

注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片采用金锡烧结，使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用  $\Phi 25 \mu\text{m}$  双金丝键合，建议金丝长度 250~400  $\mu\text{m}$ ；
5. 芯片微波端有隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。